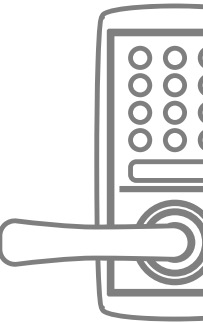
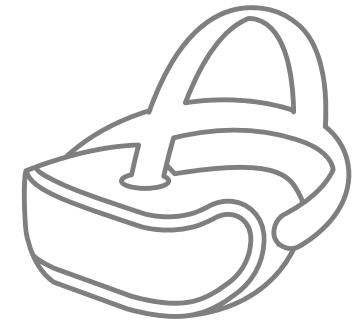
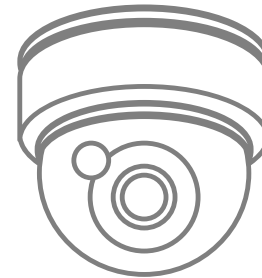
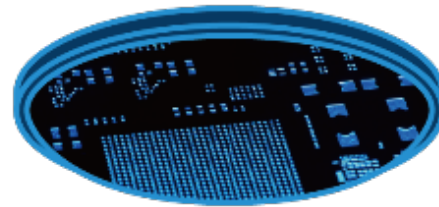
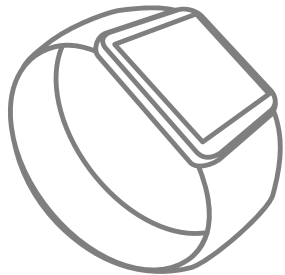
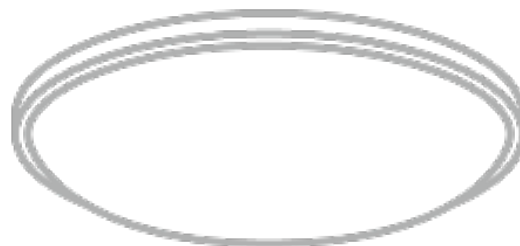
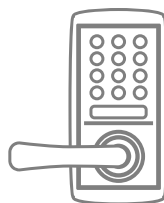


LED Lighting

Solution Proposal by Toshiba

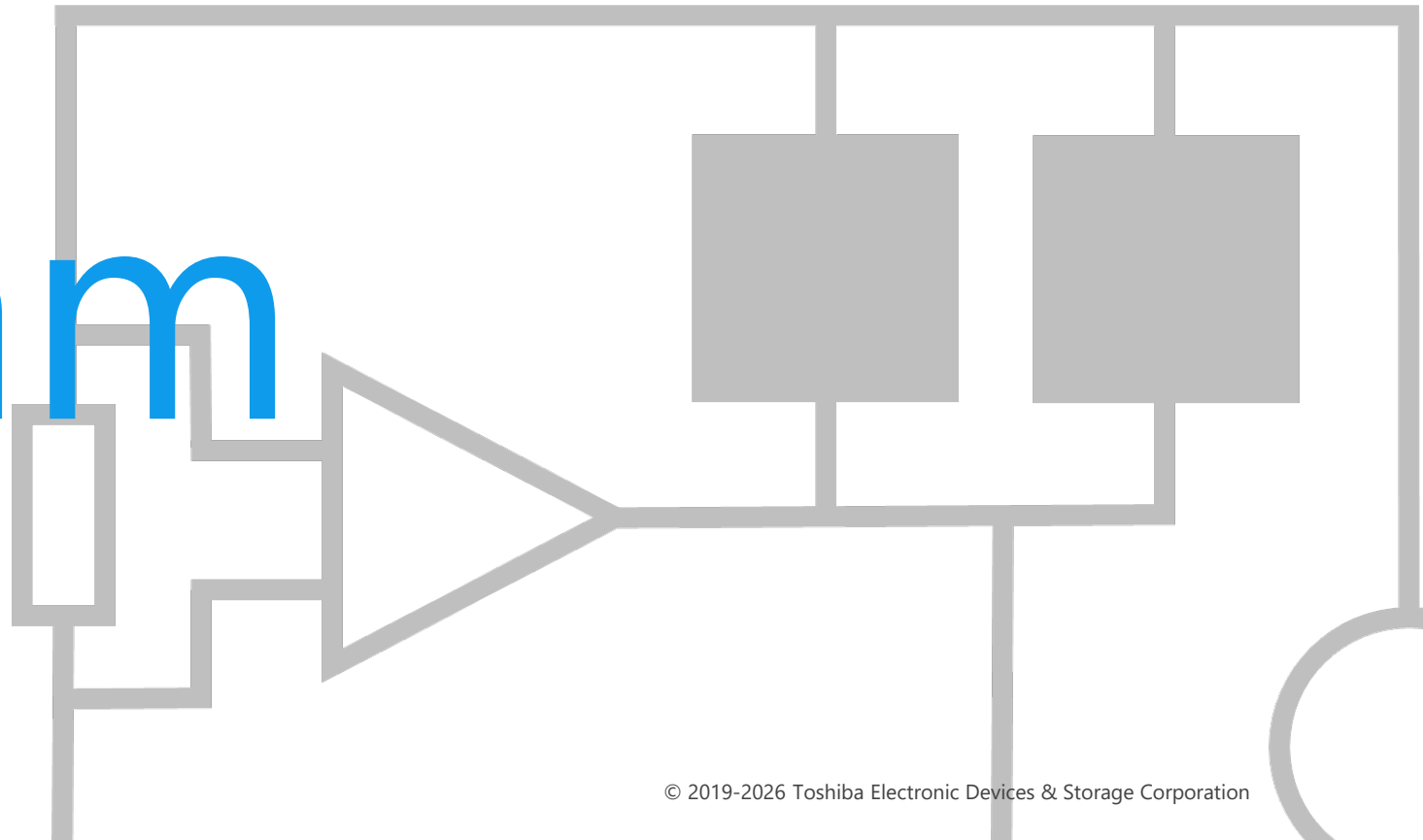




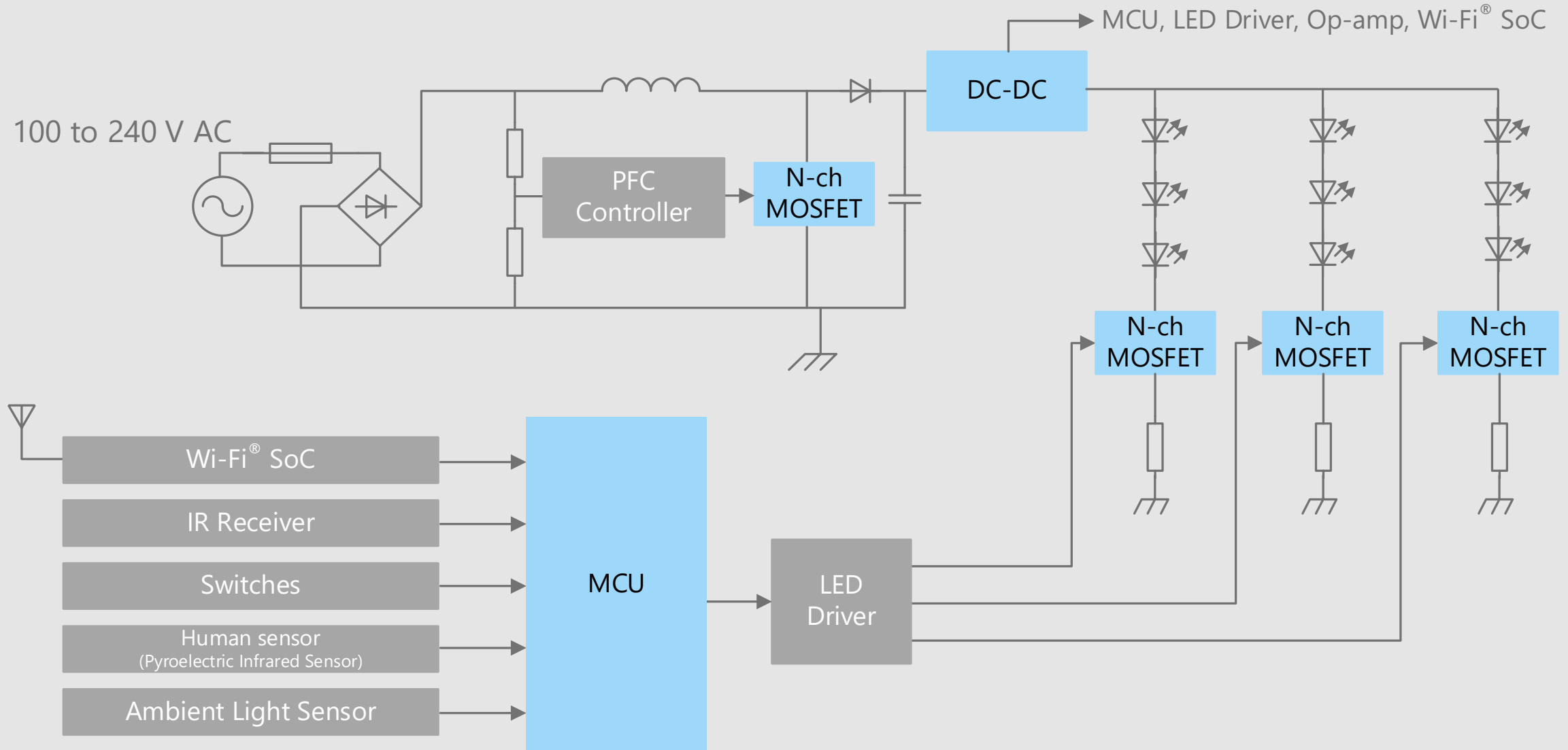
東芝デバイス&ストレージ株式会社では
既存セット設計の深い理解などにより、
新しくセット設計を考えられているお客様へ、
より適したデバイスソリューションをご提供したいと考えています。



Block Diagram

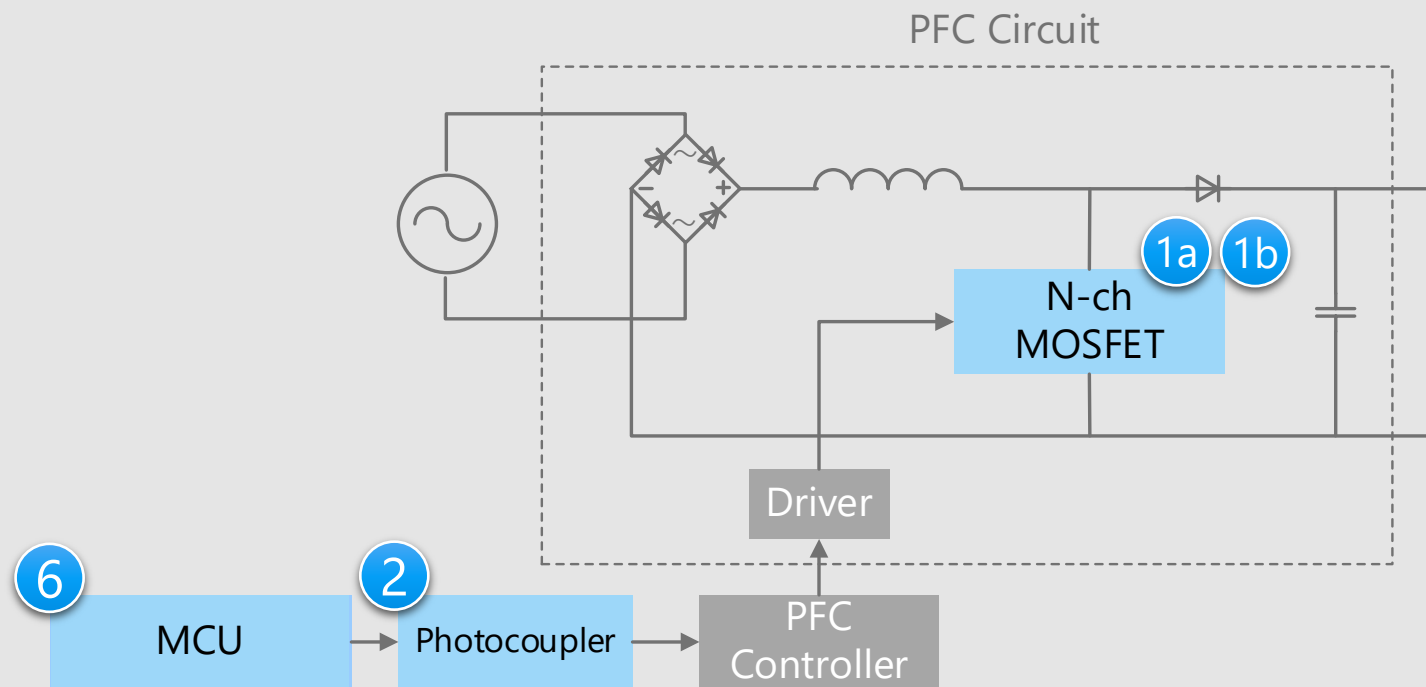


LED照明 全体ブロック図



PFC回路

アクティブ方式



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

デバイス選定のポイント

- アクティブ方式のPFC回路にはMOSFETが適します。
- トランジスタ出力フォトカプラーは、信号絶縁用です。
- PFC制御にはMCUを使用することもできます。

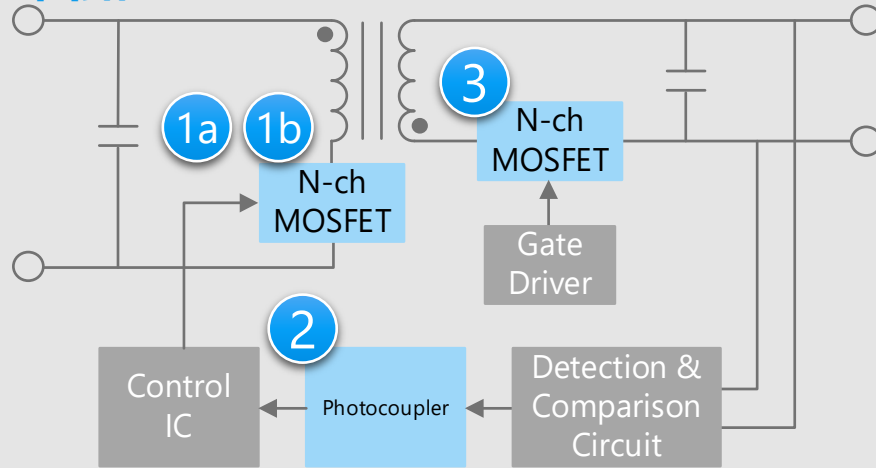
東芝からの提案

- **高効率電源のスイッチングに好適**
DTMOSVIシリーズ MOSFET 1a
SiC MOSFET 1b
- **高い変換効率と高温動作を実現**
トランジスタ出力フォトカプラー 2
- **センシング用のアナログインターフェース内蔵、
低消費電力、開発負荷軽減**
MCU M3Hグループ 6

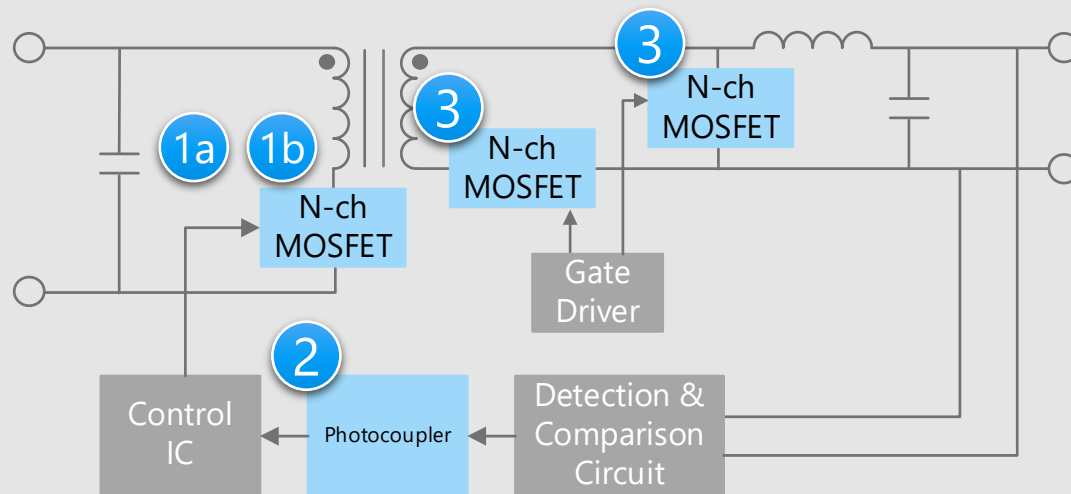
LED照明 電源部詳細 (2)

DC-DCコンバーター回路

フライバック方式



フォワード方式



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

デバイス選定のポイント

- 低オン抵抗で放熱効率の高いMOSFETを使用することにより、低発熱かつ低消費電力のセットが実現できます。
- トランジスター出力フォトカプラーは、信号絶縁用です。
- 小型パッケージ品を採用することで基板面積を縮小できます。

東芝からの提案

- 高効率電源のスイッチングに好適

DTMOSVIシリーズ MOSFET

SiC MOSFET

- 高い変換効率と高温動作を実現

トランジスター出力フォトカプラー

- 低オン抵抗で高い放熱効率のMOSFET

U-MOSシリーズ MOSFET

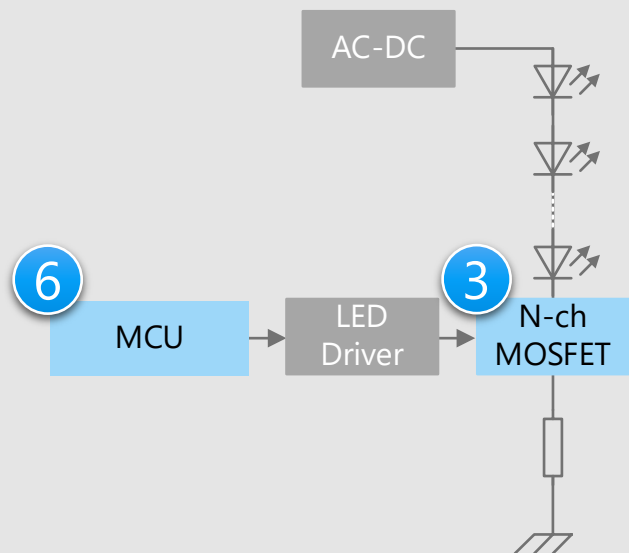
1a

1b

2

3

LED駆動回路



デバイス選定のポイント

- 低オン抵抗で放熱効率の高いMOSFETを使用することにより、低発熱かつ低消費電力のセットが実現できます。

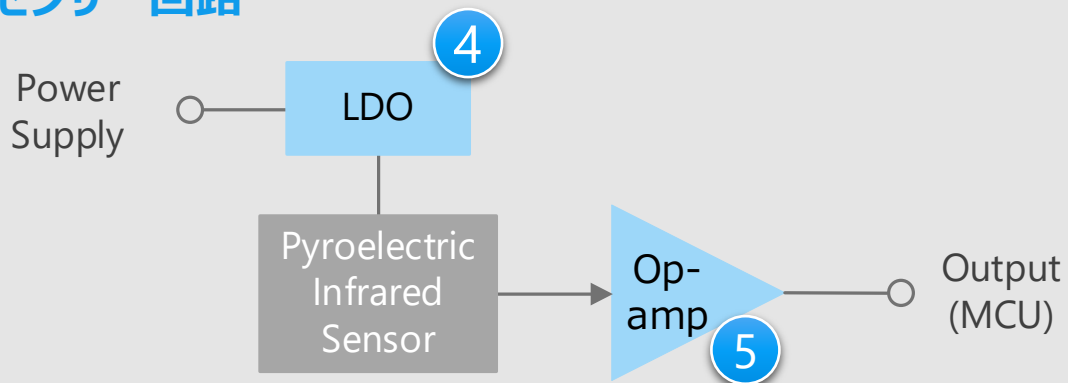
東芝からの提案

- **低オン抵抗で高い放熱効率のMOSFET**
U-MOSシリーズ MOSFET 3
- **センシング用のアナログインターフェース内蔵、低消費電力、開発負荷軽減**
MCU M3Hグループ 6

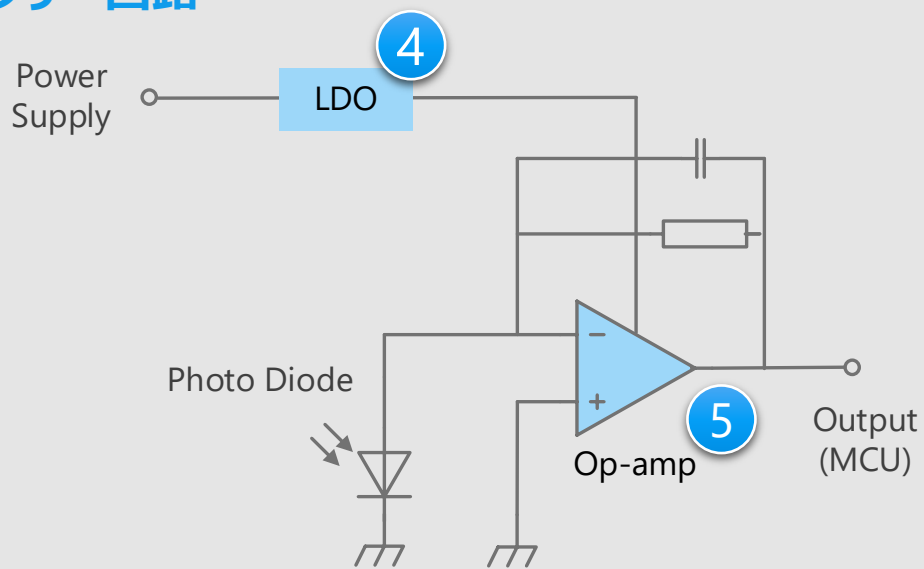
※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

LED照明 センサー信号入力部詳細

人感センサー回路



周囲光センサー回路



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

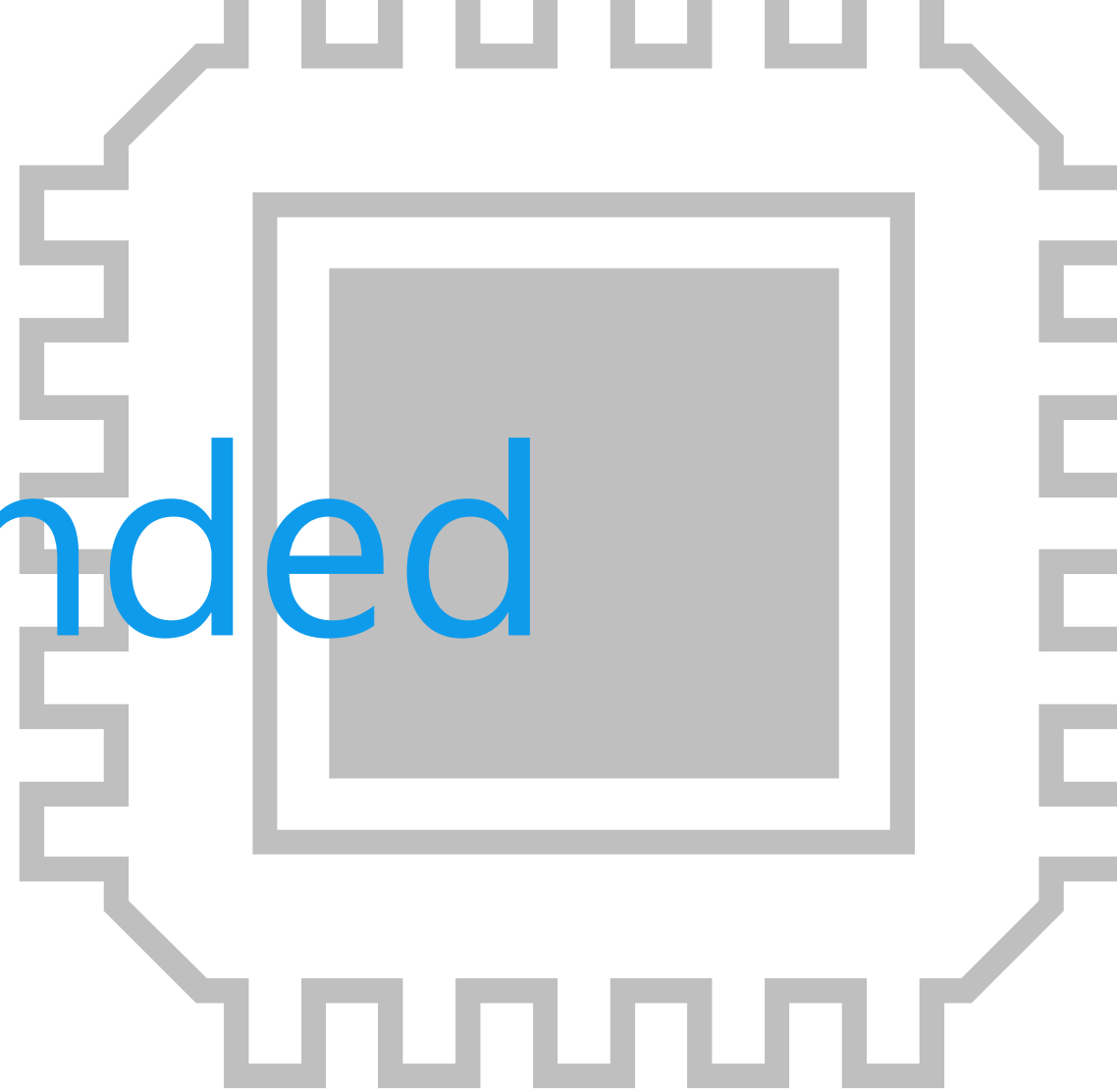
デバイス選定のポイント

- LDOレギュレーターのPSRR (電源電圧変動除去比) はセンサー回路の重要な指標です。
- オペアンプは低消費電流または低ノイズであることが望まれます。

東芝からの提案

- **低ノイズの電源を供給**
小型面実装LDOレギュレーター (4)
- **検出された微小信号を低ノイズで増幅**
低消費電流オペアンプ / 低ノイズオペアンプ (5)

Recommended Devices



お客様の課題を解決するデバイスソリューション

以上のように、LED照明の設計には「**高効率化**」「**セットの低消費電力/低発熱化**」「**基板の小型化**」が重要であると考え、三つのソリューション視点から製品をご提案します。



お客様の課題を解決するデバイスソリューション

高効率化

低消費電力
低発熱
高放熱効率

小型
パッケージ
対応

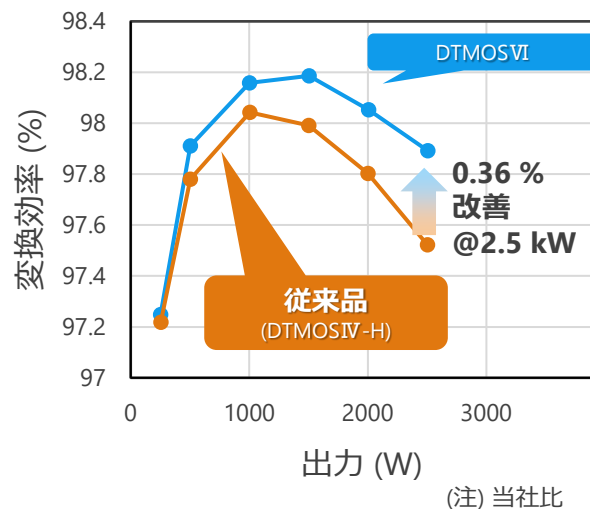
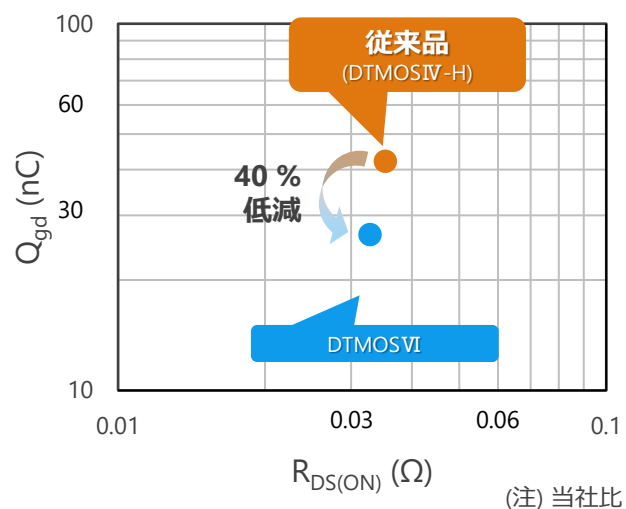
1a	DTMOSVIシリーズ MOSFET	●	●	●
1b	SiC MOSFET	●	●	
2	トランジスター出力フォトカプラー			●
3	U-MOSシリーズ MOSFET	●	●	●
4	小型面実装LDOLレギュレーター	●	●	●
5	低消費電流オペアンプ / 低ノイズオペアンプ			●
6	MCU M3Hグループ	●	●	●

提供価値

スイッチング特性を示す性能指数 $R_{DS(ON)} \times Q_{gd}$ の改善により、電源の高効率化に貢献します。

1 $R_{DS(ON)} \times Q_{gd}$ 特性の改善


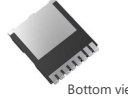


ゲート構造のデザインとプロセスの最適化により、当社 DTMOSIV-Hシリーズ製品と比較して、性能指数 $R_{DS(ON)} \times Q_{gd}$ を約 40% 低減しました (当社比)。この特性改善はスイッチング損失を低減し、機器の電源効率改善に貢献します。



2 RonA 特性の改善

当社 DTMOSIV 650 V シリーズ製品と比較して、性能指数 RonA を約 18% 低減しました (当社比)。従来品と比較して高耐圧を確保しながら低オン抵抗を実現しており、機器の電源効率改善に貢献します。

ラインアップ

品名	TK065U65Z		TK040N65Z	
パッケージ	TOLL	 Top view  Bottom view	TO-247	 Top view  Bottom view
V_{DSS} [V]	650		650	
I_D [A]	38		57	
$R_{DS(ON)}$ [Ω] @ $V_{GS} = 10$ V	Typ.	0.051	0.033	
	Max	0.065	0.040	
極性	N-ch		N-ch	

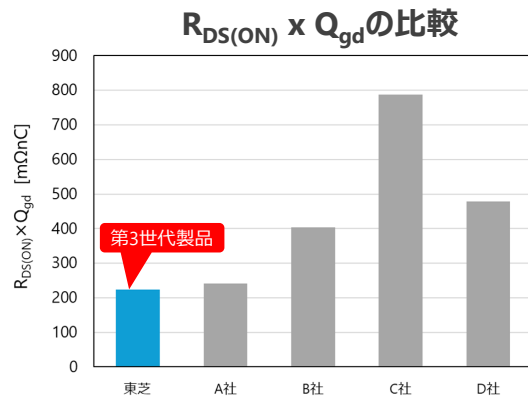
[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

スイッチング特性を示す性能指数 $R_{DS(ON)} \times Q_{gd}$ が小さく、機器の低損失化に貢献します。

1 低い $R_{DS(ON)} \times Q_{gd}$

当社第3世代製品では、セル構造の最適化により、導通損失とスイッチング損失の関係を示す性能指数 $R_{DS(ON)} \times Q_{gd}$ を低減しました^[注]。



測定条件

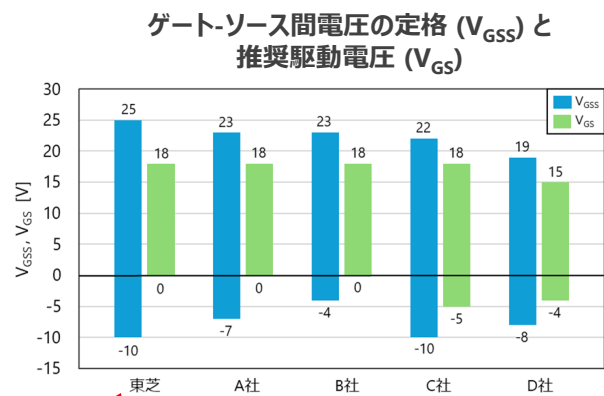
$R_{DS(ON)}$: $V_{GS} = 18 \text{ V}$, $I_D = 20 \text{ A}$, $T_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

Q_{gd} : $V_{DD} = 400 \text{ V}$, $V_{GS} = 18 \text{ V}$, $I_D = 20 \text{ A}$, $T_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

[注] 2025年10月時点。当社調べ。

2 広い V_{GSS} 規格

ゲート・ソース間電圧の規格が $-10 \sim 25 \text{ V}$ と他社製品と比較して広い^[注]ため、駆動電圧に対してマージンを広く取ることができ、オーバーシュートを考慮したゲートドライブ設計が容易になります。
(推奨駆動電圧: 18 V)

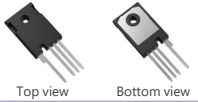


第3世代製品

3 ショットキーバリアダイオード内蔵

ショットキーバリアダイオードを内蔵することで、逆導通時の順方向電圧 (ダイオード) V_{DSF} を -1.35 V (typ.) @ $V_{GS} = -5 \text{ V}$ に低減しました。
また、ショットキーバリアダイオードに通電させることで、欠陥の広がりによる $R_{DS(ON)}$ の変動を抑制しました。

ラインアップ

品名	TW015N65C	TW015N120C	TW015Z65C	TW015Z120C
パッケージ	TO-247	 Top view Bottom view	TO-247-4L(X)	 Top view Bottom view
V_{DSS} [V]	650	1200	650	1200
I_D [A]	100	100	100	100
$R_{DS(ON)}$ [Ω] @ $V_{GS} = 18 \text{ V}$	Typ.	0.015	0.015	0.015
	Max	0.021	0.020	0.022
極性	N-ch	N-ch	N-ch	N-ch

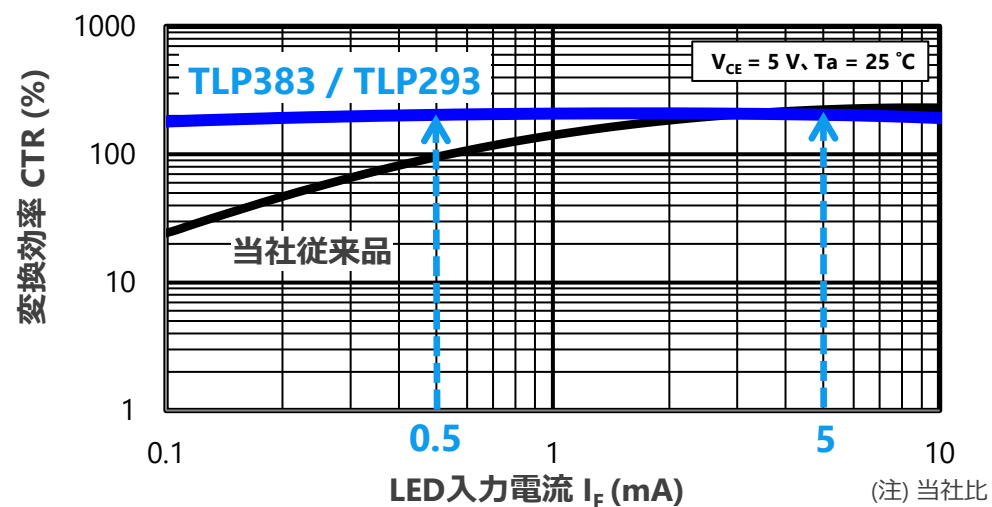
◆Block Diagram TOPへ戻る

提供価値

低入力電流領域 ($I_F = 0.5 \text{ mA}$) でも高い変換効率 (CTR: Current Transfer Ratio) を実現しています。

1 高い変換効率




TLP383とTLP293はフォトトランジスターと高出力赤外LEDを光結合させた高絶縁型のフォトカプラーです。当社従来品 (TLP385) と比較し、低入力電流領域 (@ $I_F = 0.5 \text{ mA}$) でも高い変換効率を実現しています。



2 高温動作対応

TLP383とTLP293は周囲温度環境の厳しい条件下でも動作するように設計されています。

ラインアップ

品名	TLP383	TLP293	TLP385
パッケージ	4pin SO6L 	SO4 	4pin SO6L 
BV_S [Vrms]	5000	3750	5000
T_{opr} [$^\circ\text{C}$]	-55 ~ 125	-55 ~ 125	-55 ~ 110

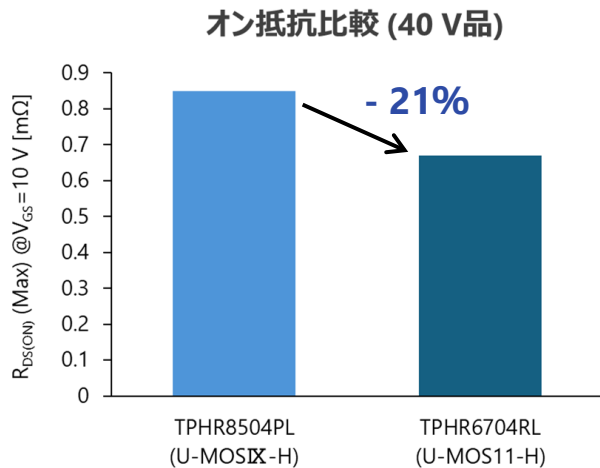
[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

低オン抵抗と高放熱パッケージ (DSOP Advance) によりセットの低発熱化に貢献します。

1 低いオン抵抗

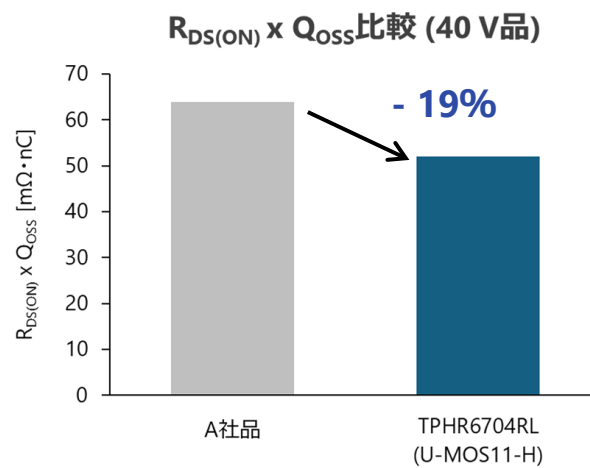
ドレイン・ソース間のオン抵抗が低く、発熱と消費電力を抑えることができます。
当社従来製品に対して、オン抵抗を21%低減
[注1]しています。(40 V耐圧品での比較)



[注1] 当社比

2 小さい出力電荷量

出力電荷量 Q_{OSS} が小さく、出力容量損失の低減に貢献します。競合同定格製品に対して、性能指標 $R_{DS(ON)} \times Q_{OSS}$ を19%低減 [注2] しています。(40 V耐圧品での比較)




[注2] 同定格製品での比較。2025年10月時点、当社調べ。

3 多彩なパッケージ

業界標準サイズのSOP Advanceに加え、同一フットプリントで実装可能な両面放熱パッケージ (DSOP Advance) をラインアップしています。セットに合わせてパッケージを選択できます。

ラインアップ

品名	TPWR6003PL	TPWR8004PL	TPHR7404PU	TPHR8504PL	TPHR6704RL	
パッケージ	DSOP Advance 		SOP Advance 		SOP Advance(N) 	
V_{DSS} [V]	30	40	40	40	40	
I_D [A]	150 (412*)	150 (340*)	150 (400*)	150 (340*)	420	
$R_{DS(ON)}$ [mΩ] @ $V_{GS} = 10\text{ V}$	Typ.	0.36	0.65	0.51	0.70	0.52
	Max	0.60	0.80	0.74	0.85	0.67
極性	N-ch	N-ch	N-ch	N-ch	N-ch	
世代	U-MOSIX-H	U-MOSIX-H	U-MOSIX-H	U-MOSIX-H	U-MOS11-H	

*: Silicon limit

◆Block Diagram TOPへ戻る

提供価値

低オン抵抗の製品ラインアップをとりそろえており、オン抵抗・容量のトレードオフ特性を改善し電源の高効率化に貢献します。

1 低いオン抵抗

ドレイン・ソース間のオン抵抗が低く、発熱と消費電力を抑えることができます。
当社従来製品に対して、オン抵抗を22%低減
[注]しています。(80 V耐圧品での比較)

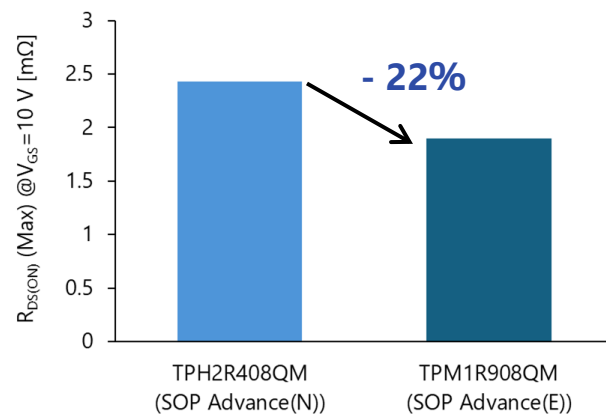
2 小さいゲート入力電荷量

ゲート入力電荷量を小さくすることでMOSFET駆動に必要な能力を抑え、スイッチング特性の改善につなげました。

3 速いスイッチングスピード

高速動作によるスイッチングロス低減により、電源の高効率化に貢献します。

オン抵抗比較 (80 V品)



[注] 当社比

ラインアップ

品名	TPH2R408QM	TPM1R908QM	TPN12008QM	TPN19008QM	TK5R1P08QM	TK6R9P08QM
パッケージ	SOP Advance(N)	SOP Advance(E)	TSOP Advance		DPAK	
V_{DSS} [V]	80	80	80	80	80	80
I_D [A]	120 (200*)	238	26 (60*)	34 (38*)	84 (105*)	62 (83*)
$R_{DS(on)}$ [mΩ] @ $V_{GS} = 10\text{ V}$	Typ.	1.90	9.6	14.7	4.2	5.5
	Max	2.43	12.3	19.0	5.1	6.9
極性	N-ch	N-ch	N-ch	N-ch	N-ch	N-ch
世代	U-MOSX-H	U-MOSX-H	U-MOSX-H	U-MOSX-H	U-MOSX-H	U-MOSX-H

*: Silicon limit

◆Block Diagram TOPへ戻る

4 小型面実装LDOLレギュレーター

TCR15AG / TCR8BM / TCR5FM / TCR5RG / TCR3RM / TCR3U / TCR3LM / TCR3D / TCR3EM / TCR1HFシリーズ

高効率化

低消費電力
低発熱
高放熱効率

小型
パッケージ
対応

提供価値

汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。

1 低ドロップアウト電圧

当社が独自に開発したプロセスにより、ドロップアウト特性を実現しました。

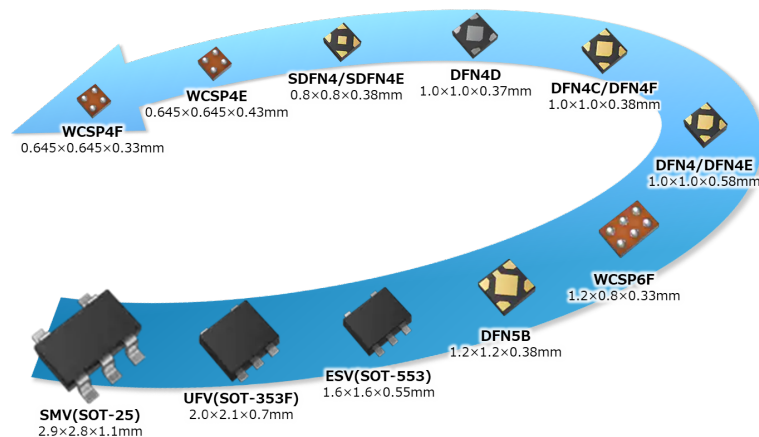
2 高PSRR 低出力雑音電圧

高いPSRR (Power Supply Rejection Ratio: 電源電圧変動除去比)、低い出力雑音電圧 V_{NO} を兼ね備えたシリーズを数多くラインアップしており、アナログ回路への安定電源に適しています。

3 低消費電流特性

CMOSプロセスを用いて、独自の回路技術により消費電流 $I_{B(ON)} = 0.34 \mu A$ (typ.) @ $I_{OUT} = 0 \text{ mA}$, $V_{OUT} \leq 1.5 \text{ V}$ を実現しました。(TCR3Uシリーズ)

豊富なパッケージラインアップ



ラインアップ

品名	TCR15AG シリーズ	TCR8BM シリーズ	TCR5FM シリーズ	TCR5RG シリーズ	TCR3RM シリーズ	TCR3U シリーズ	TCR3LM シリーズ	TCR3D シリーズ	TCR3EM シリーズ	TCR1HF シリーズ
特長	低ドロップアウト 高PSRR		高PSRR 低ノイズ 低消費電流		低消費電流		スタンダードタイプ		入力電圧 36 V	
I_{OUT} (Max) [A]	1.5	0.8	0.5		0.3				0.15	
PSRR (Typ.) [dB] @f = 1 kHz	95	98	91	100	100	70	-	72	68	70
I_B (Typ.) [μA]	25	20	10	7	7	0.34	1	86	35	170

◆Block Diagram TOPへ戻る

5 低消費電流オペアンプ / 低ノイズオペアンプ

TC75S102F / TC75S67TU

高効率化

低消費電力
低発熱
高放熱効率

小型
パッケージ
対応

提供価値

低消費電力化に貢献する低消費電流タイプと、高性能センサーの性能を引き出す低ノイズタイプのオペアンプをラインアップしています。

1 低電圧動作

低電源電圧で動作する回路向けに、CMOSプロセスを用いた低電源電圧駆動のオペアンプをラインアップしています。

2 低消費電流 (TC75S102F)

$I_{DD} = 0.27 [\mu A] (Typ.)$

CMOSプロセスを用いて、低い消費電流を実現しました。機器の低消費電力化に貢献します。

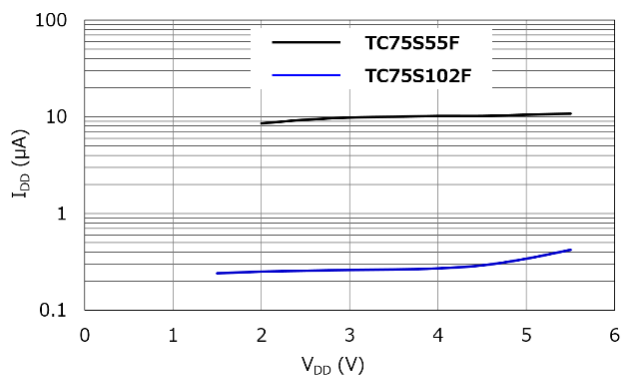
3 低ノイズ (TC75S67TU)

$V_{NI} = 6.0 [nV/\sqrt{Hz}] (Typ.) @f = 1 \text{ kHz}$

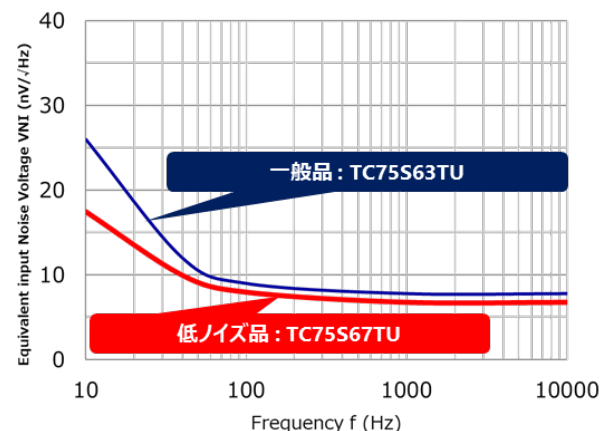
各種センサー^[注]で検出された微小信号を、低ノイズで増幅できるCMOSオペアンプです。プロセスの最適化で入力換算雑音電圧を低減しました。

[注] 各種センサー: 振動検出センサー、ショックセンサー、加速度センサー、圧力センサー、赤外線センサー、温度センサーなど



TC75S102F 消費電流特性 (当社比)



TC75S67TU ノイズ特性 (当社比)



ラインアップ

品名	TC75S102F	TC75S67TU
パッケージ	SMV 	UFV 
V _{DD} - V _{SS} [V]	1.5 ~ 5.5	2.2 ~ 5.5
V _{IO} (Max) [mV]	1.3	3
CMV _{IN} (Max) [V]	V _{DD}	1.4 (@V _{DD} = 2.5 V)
I _{DD} (Typ. / Max) [μA]	0.27 / 0.46 (@V _{DD} = 1.5 V)	430 / 700 (@V _{DD} = 2.5 V)
V _{NI} (Typ.) [nV/√Hz] @f = 1 kHz	-	6.0

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

ADコンバーター、タイマー、PWM^[注1] 出力を搭載し、システム制御を低消費電力で実行します。

[注1] Pulse Width Modulation

1 Arm® Cortex®-M3コア搭載

最大動作周波数120 MHzのArm Cortex-M3コアを搭載しています。多様な開発ツール、パートナーをお選びいただくことが可能です。

2 システムの高機能化に対応

監視機能を持ったADコンバーター、PWMを生成する多機能なタイマー、A-PMD^[注2] 制御回路を搭載し、システムの各所のモニターリングと発光制御を効率よく実行します。またフラッシュROM 1024 KB搭載の製品はFOTA^[注3] に対応します。

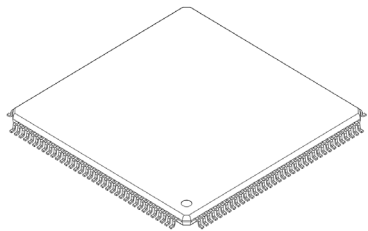
[注2] Advanced Programmable Motor Control Circuit

[注3] Firmware update Over The Air

3 低消費電力、小型パッケージ

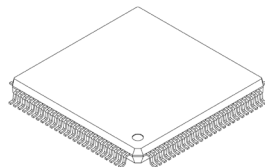
複数の低消費電力モードを用意し、低消費電力化をサポートします。パッケージはLQFP144から小型LQFP64までラインアップしています。

TMPM3HQF10BFG
TMPM3HQFDAFG



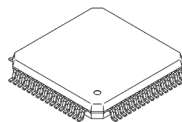
P-LQFP144-2020-0.50-002

TMPM3HNF10BFG
TMPM3HNFDAFG



P-LQFP100-1414-0.50-002

TMPM3HLF10BUG
TMPM3HLFDAUG



P-LQFP64-1010-0.50-003

ラインアップ

品名	M3H(2)	TMPM3HQF10BFG	TMPM3HNF10BFG	TMPM3HLF10BUG
	M3H(1)	TMPM3HQFD/Z/Y/AFG	TMPM3HNF/D/Z/Y/AFG	TMPM3HLF/D/Z/Y/AUG
最大動作周波数	120 MHz			
ROM(フラッシュ)	M3H(2)	1024 KB (512 KB x 2エリア、FOTA対応)		
	M3H(1)	512 / 384 / 256 KB		
RAM	M3H(2)	130 KB (パリティ付き)		
	M3H(1)	66 KB (パリティ付き)		
タイマー	32bit x 8ch (16bit x 16ch)			
ADコンバーター		21ch (12bit)	17ch (12bit)	12ch (12bit)
シリアル通信		UART: 8ch, I ² C: 4ch, TSPI: 5ch	UART: 8ch, I ² C: 3ch, TSPI: 4ch	UART: 7ch, I ² C: 2ch, TSPI: 1ch
パッケージ		P-LQFP144-2020-0.50-002	P-LQFP100-1414-0.50-002	P-LQFP64-1010-0.50-003

◆Block Diagram TOPへ戻る

製品にご興味をもたれた方、
ご意見・ご質問がございます方、
以下連絡先までお気軽にご連絡ください

連絡先：<https://toshiba.semicon-storage.com/jp/contact.html>



ご利用規約

本規約は、お客様と東芝デバイス&ストレージ株式会社（以下「当社」といいます）との間で、当社半導体製品を搭載した機器を設計する際に参考となるドキュメント及びデータ（以下「本リファレンスデザイン」といいます）の使用に関する条件を定めるものです。お客様は本規約を遵守しなければなりません。

第1条 禁止事項

お客様の禁止事項は、以下の通りです。

1. 本リファレンスデザインは、機器設計の参考データとして使用されることを意図しています。信頼性検証など、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 本リファレンスデザインを販売、譲渡、貸与等しないでください。
3. 本リファレンスデザインは、高温・多湿・強電磁界などの対環境評価には使用できません。
4. 本リファレンスデザインを、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用しないでください。

第2条 保証制限等

1. 本リファレンスデザインは、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
2. 本リファレンスデザインは参考用のデータです。当社は、データ及び情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。
3. 半導体素子は誤作動したり故障したりすることがあります。本リファレンスデザインを参考に機器設計を行う場合は、誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。また、使用されている半導体素子に関する最新の情報（半導体信頼性ハンドブック、仕様書、データシート、アプリケーションノートなど）をご確認の上、これに従ってください。
4. 本リファレンスデザインを参考に機器設計を行う場合は、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断して下さい。当社は、適用可否に対する責任は負いません。
5. 本リファレンスデザインは、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証又は実施権の許諾を行うものではありません。
6. 当社は、本リファレンスデザインに関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をせず、また当社は、本リファレンスデザインに関する一切の損害（間接損害、結果的損害、特別損害、付随的損害、逸失利益、機会損失、休業損害、データ喪失等を含むがこれに限らない。）につき一切の責任を負いません。

第3条 契約期間

本リファレンスデザインをダウンロード又は使用することをもって、お客様は本規約に同意したものとみなされます。本規約は予告なしに変更される場合があります。当社は、理由の如何を問わずいつでも本規約を解除することができます。本規約が解除された場合は、お客様は本リファレンスデザインを破棄しなければなりません。さらに当社が要求した場合には、お客様は破棄したことを証する書面を当社に提出しなければなりません。

第4条 輸出管理

お客様は本リファレンスデザインを、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事情報の目的で使用してはなりません。また、お客様は「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守しなければなりません。

第5条 準拠法

本規約の準拠法は日本法とします。

第6条 管轄裁判所

本リファレンスデザインに関する全ての紛争については、別段の定めがない限り東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

製品取り扱い上のお願い

東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。
本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（生命直結機器）、車載・輸送機器、防衛関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社Webサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品にはGaAs（ガリウムヒ素）が使われているものがあります。その粉末や蒸気等は人体に対し有害ですので、破壊、切断、粉碎や化学的な分解はしないでください。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

TOSHIBA

- * Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- * Arm、Cortex は、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社) の登録商標です。
- * TXZ+™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
- * その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。